

20 września 1932 r.

URZĄD PATENTOWY



Bold 11/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16337.

Kl. 12 c 1.

Bamag - Meguin Aktiengesellschaft
(Berlin, Niemcy).

Bold 11/02

Sposób rozpuszczania w wieżach zapomocą kwasów kamienia wapiennego lub innych substancyj, wytwarzających przy rozpuszczaniu gazy i pianę.

Zgłoszono 28 kwietnia 1930 r.

Udzielono 9 maja 1932 r.

Przy rozpuszczaniu substancyj w rodzaju, np., kamienia wapiennego zapomocą kwasu, np., azotowego, powstają gazy, głównie kwas węglowy i tlenki azotu, które należy odsysać.

Okazało się, że zabieg ten dla pewnych substancyj, a zwłaszcza pewnych rodzajów wapniaka, nie czyni zadość wszelkim wymaganiom. W myśl wynalazku, wadzie tej można zaradzić w ten sposób, że celem usuwania piany, powstającej w procesie rozpuszczania, odsysanie uskutecznia się z części górnej wieży, co zapewnia jednocześnie korzyść zupełnego zniweczenia piany. Odsysanie prowadzi się wówczas bądź to

przez sito, bądź przez naczynie do skrapiania, umieszczone ponad wieżą lub w niej samej i zawierające odpowiedni kwas, np. kwas azotowy.

Rysunek przedstawia dwie odmiany wynalazku w postaci schematycznej.

Wieża rozpuszczająca *a* napełniona jest mniej więcej do połowy kamieniem wapiennym *b*. Powyżej znajduje się przestrzeń, wypełniająca się pianą. Powstające przy rozpuszczaniu gazy odsysa się bądź to, według fig. 1, przez umieszczone ponad wieżą naczynie *d* z kwasem, bądź, według fig. 2, przez kwas rozlany w samej wieży na dnie rozdzielczem *e*. Jak wykazały do-

świadczenia osiąga się przytem bardzo skuteczne niweczenie piany.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób rozpuszczania w wieżach za pomocą kwasów kamienia wapiennego lub innych substancyj, wytwarzających przy rozpuszczaniu gazy i pianę, znamienny tem, że powstające przy rozpuszczaniu gazy odsysa się z górnej części wieży.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tem, że niweczenie piany uskutecznia się w drodze odsysania gazów przez roz-

puszczalnik płynny zawarty w naczyniu (d), umieszczonem ponad wieżą rozpuszczającą (a).

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tem, że niweczenie piany uskutecznia się w drodze odsysania gazów przez rozpuszczalnik płynny zawarty w samej wieży rozpuszczającej (a) na dnie rozdzielczem (e).

B a m a g - M e g u i n
A k t i e n g e s e l l s c h a f t.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

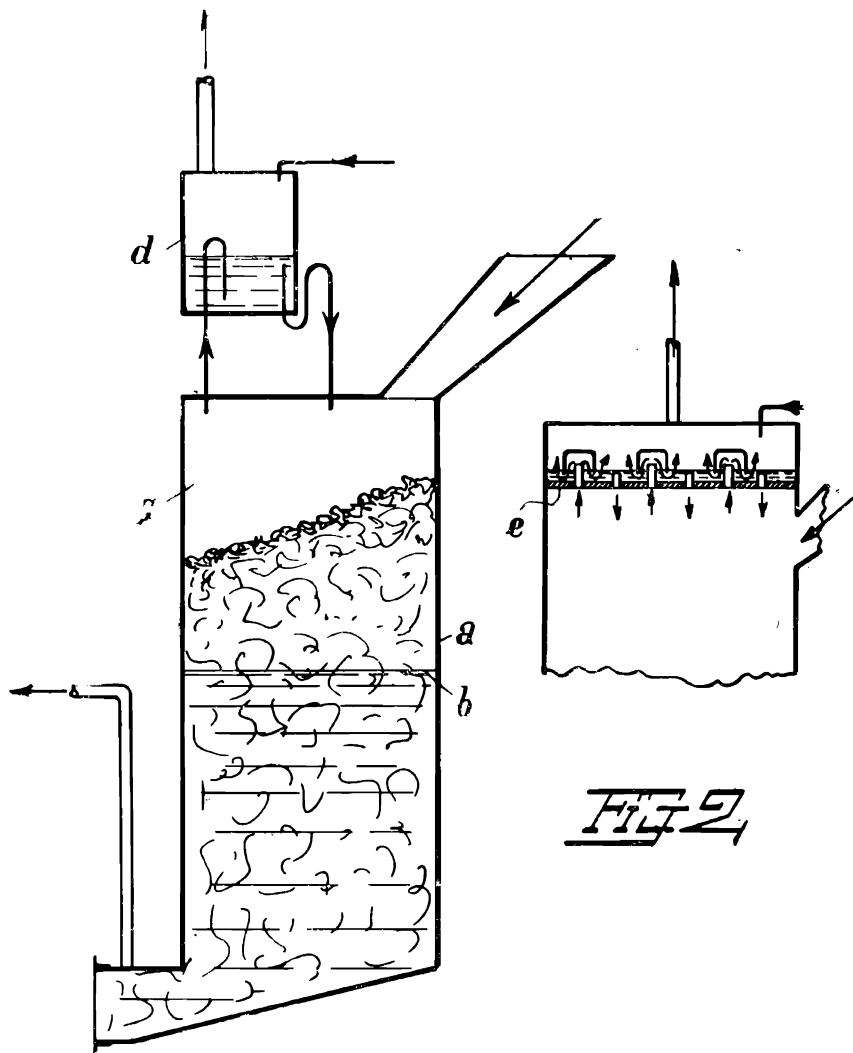


Fig. 1

Fig. 2